



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE
COMPUTADORES

ELECTRÓNICA RÁPIDA

Projecto e Simulação de Amplificadores Lineares para Altas Frequências

Guilherme Branco Teixeira	n.º 70214
Maria Margarida Dias dos Reis	n.º 73099
Nuno Miguel Rodrigues Machado	n.º 74236

Grupo n.º 2 de quarta-feira das 11h00 - 12h30

Lisboa, 25 de Abril de 2015

Índice

1	Introdução	1
2	Plano de Trabalhos	1
2.1	Projecto de um amplificador uniandar	1
2.1.1	a) Projecto do amplificador com linhas ideais	1
2.1.2	b) Projecto do amplificador utilizando tecnologia microfita	9
2.2	Concretização do amplificador em tecnologia de microfita	12
2.2.1	a) Introdução de elementos que simulam descontinuidades nas linhas	12
2.2.2	b) Substituição do transístor e condensadores	15
3	Conclusões	17

1 Introdução

O objectivo deste laboratório é estudar técnicas de projecto de amplificadores lineares de alta frequência, análise das suas características (estabilidade, ganho, adaptação e factor de ruído) e comportamentos. A caracterização dos dispositivos do amplificador será realizada através dos parâmetros distribuídos - parâmetros S.

Utiliza-se um transistor da Hewlett-Packard (HP) ATF-35176, um transistor que utiliza tecnologia PHEMT (*Pseudomorphic High Mobility Transistor*), preparado para trabalhar em altas frequências.

2 Plano de Trabalhos

As especificações do amplificador a construir podem ser consultadas na tabela seguinte, tal como as características do substrato plástico para alta-frequência da Taconic (TLY -3-0310-CH/CH), sobre qual o transistor irá ser implantado.

Tabela 1: Características do amplificador a projectar.

Especificação	Símbolo	Valor
Ganho de Transdução	G_T	G_{Tmax}
Tensão <i>drain-source</i>	V_{DS}	1.5 V
Corrente <i>drain-source</i>	I_{DS}	20 mA
Resistência da fonte e da carga	R_G e R_C	50 Ω
Constante dieléctrica	ϵ_r	2.3
Espessura do substrato	h	0.35 mm
Espessura da metalização	t	0.018 mm
Tangente de perdas	σ	0.001
Frequência central	f_{01}	22 GHz

De notar que o valor da espessura do substrato foi modificado de 0.78 mm para 0.35 mm com o objectivo de garantir propagação transversal nas linhas de microfitas, ou seja, garantir que estas têm um comprimento maior que a largura.

Numa primeira fase do trabalho laboratorial é projectado e simulado o amplificador uniandor com linhas simétricas. Na segunda fase o amplificador é projectado com tecnologia de microfitas.

2.1 Projecto de um amplificador uniandor

2.1.1 a) Projecto do amplificador com linhas ideais

Nesta primeira fase, o amplificador é constituído pelo transistor descrito anteriormente, no entanto, todos os dispositivos utilizados no seu projecto e simulação são dispositivos ideais.

PFR Pretendido

Em primeiro lugar, é feita uma análise DC ao transistor que tem em vista obter o ponto de funcionamento em repouso (PFR) especificado. O circuito que nos permitiu alcançar essa análise é o que se vê na Figura 1.

Porque a
magui é
simpática,
ela vai
rever as
escalas
das ima-
gens e por
da me-
lhor forma
possível



Figura 1: Circuito utilizado para obter o PFR desejado.

A análise DC serve para descobrir o valor de V_{GS} correspondente ao PFR desejado. No circuito da Figura 1 existe um componente denominado de I_Probe que tem como objectivo controlar o valor de I_D à medida que o valor de V_{GS} varia. Um excerto dos resultados desta análise pode ser consultado na Figura 2, onde se pode concluir que o valor da tensão V_{GS} que melhor corresponde a uma corrente I_D de 20 mA (20.03 mA) é de -0.277 V.

Vgs	I_Probe1.i
-0.290	19.06 mA
-0.289	19.13 mA
-0.288	19.21 mA
-0.287	19.28 mA
-0.286	19.35 mA
-0.285	19.43 mA
-0.284	19.50 mA
-0.283	19.58 mA
-0.282	19.65 mA
-0.281	19.73 mA
-0.280	19.80 mA
-0.279	19.88 mA
-0.278	19.95 mA
-0.277	20.03 mA
-0.276	20.11 mA

Figura 2: Valores de V_{GS} correspondentes à corrente de I_Probe .

Análise em Alta-Frequência

Com o transistor a funcionar no PFR desejado, é preciso construir um novo circuito que contenha condensadores e bobines ideais, DC_Block e DC_Feed , respectivamente, para que seja possível realizar a simulação dos parâmetros S. Este circuito apresenta-se de seguida.

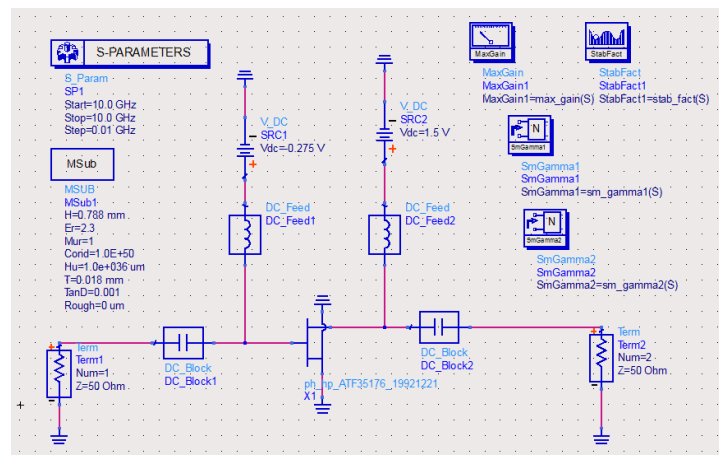


Figura 3: Circuito utilizado para obter o valores dos parâmetros S.

Simulando o circuito anteriormente projectado foram obtidos os seguintes valores para os parâmetros S, K (parâmetro de estabilidade), MAG (*maximum available gain*) e para as cargas de adaptação para o transistor à frequência central.

Tabela 2: Parâmetros que definem o transistor.

S_{11}	S_{12}	S_{21}	S_{22}	K	MAG	$\rho_{S(ACS)}$	$\rho_{L(ACS)}$
$0.621\angle 57.623^\circ$	$0.108\angle -135.301^\circ$	$1.958\angle -117.117^\circ$	$0.311\angle 31.533^\circ$	1.236	9.664	$0.784\angle -59.529^\circ$	$0.628\angle -39.020^\circ$

De notar que os valores obtidos experimentalmente para os parâmetros S não podem ser verificados na *datasheet* do transistor, uma vez que esta apenas especifica o comportamento do ATF-35176 para frequências entre 2 GHz e 18 GHz.

Com os valores da Tabela 2 determinados pode-se calcular o valor de Δ , ou seja, o determinante da matriz de dispersão:

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{21}S_{12} = 0.067\angle -7.24^\circ. \quad (2.1)$$

Como se pode ver, $K = 1.236 > 1$, $|\Delta| = 0.067 < 1$ e $|S_{ii}| < 1$, pelo que o transistor é incondicionalmente estável.

Projecção da Malha de Entrada e de Saída

Optou-se por projectar a malha de entrada e de saída com a Carta de Smith, recorrendo ao ADS. Como $K > 1$ é possível efectuar adaptação conjugada simultânea (ACS) e, como se pretende adicionar elementos às malhas sabe-se que:

$$\rho_{in} = \rho_S^* \text{ e } \rho_{out} = \rho_L^*. \quad (2.2)$$

O circuito com malhas de adaptação é apresentado de seguida.

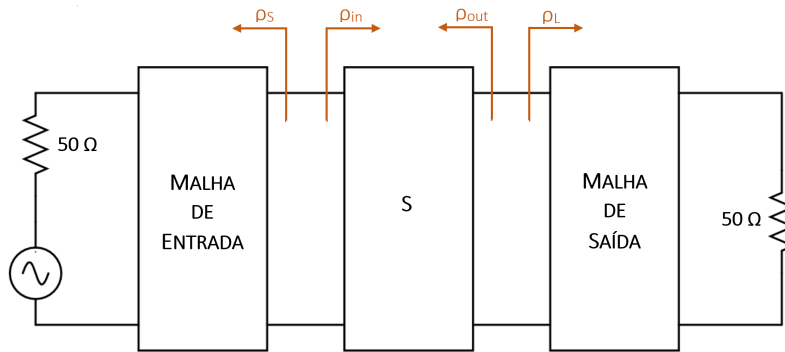


Figura 4: Circuito que inclui as malhas de adaptação à entrada e à saída.

Começando pela malha de entrada, ou seja, pelo gerador e sabendo que a malha de adaptação é do tipo linha-*stub*, o circuito que se pretende projectar é da seguinte forma.

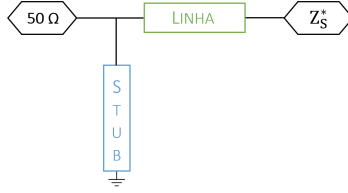


Figura 5: Malha de adaptação de entrada.

Esta malha é construída com a adição de elementos, ou seja, *towards generator*. O valor de Z_S^* é de $0.784/-59.529^\circ$.

No ADS, com recurso à Carta de Smith, determinou-se o comprimento eléctrico da linha de entrada, $\theta_{L_{in}}$, e o comprimento eléctrico do *stub*, $\theta_{S_{in}}$.

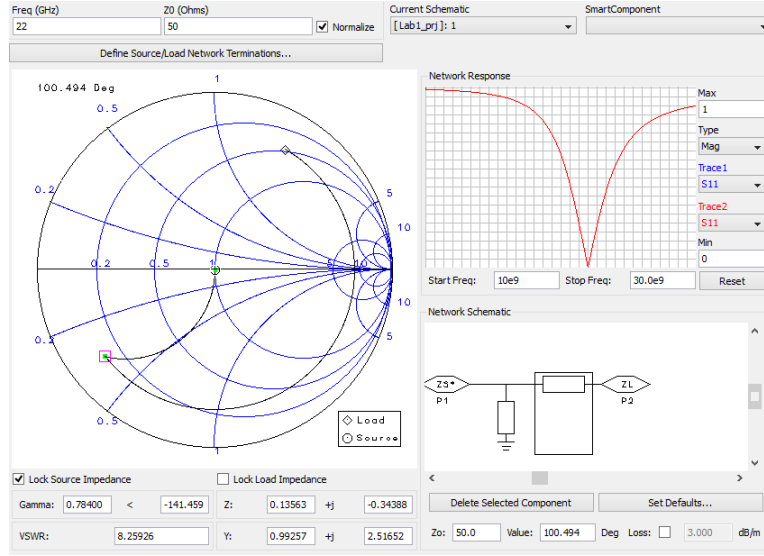


Figura 6: Determinação do comprimento eléctrico da linha de entrada - situação de CC.

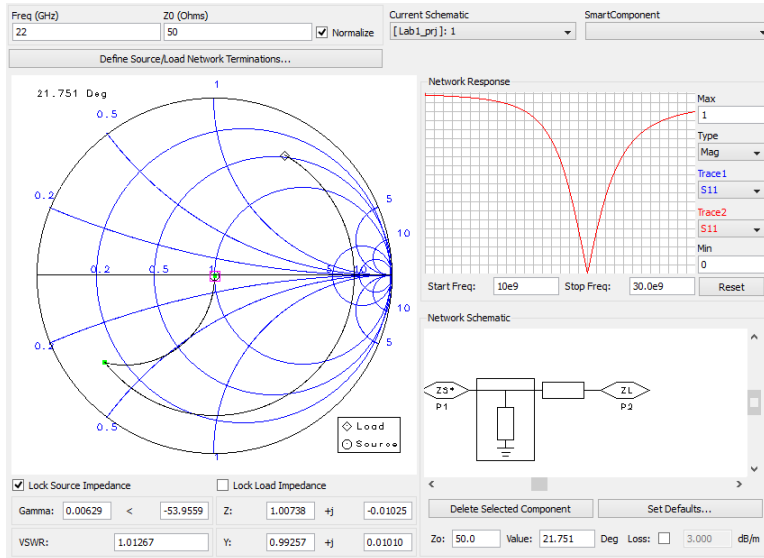


Figura 7: Determinação do comprimento eléctrico do *stub* de entrada - situação de CC.

$$\theta_{L_{in}} = 100.494^\circ \text{ e } \theta_{S_{in}} = 21.751^\circ. \quad (2.3)$$

É de notar que os valores determinados anteriormente são para o *stub* terminado em curto-circuito (CC), pois é nessa situação que o *stub* é menor, tal como pretendido. Para verificar, optou-se por projectar a malha de entrada para o *stub* terminado em circuito-aberto (CA).

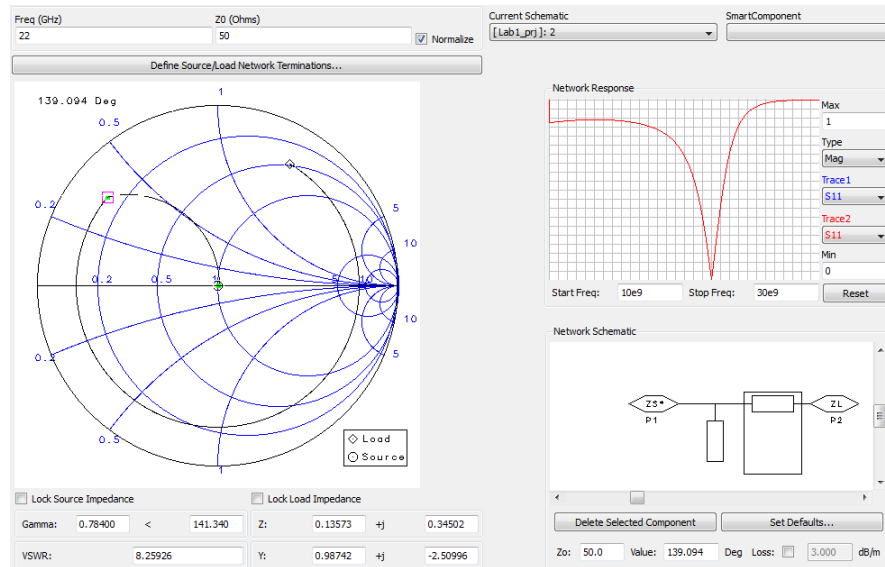


Figura 8: Determinação do comprimento eléctrico da linha de entrada - situação de CA.

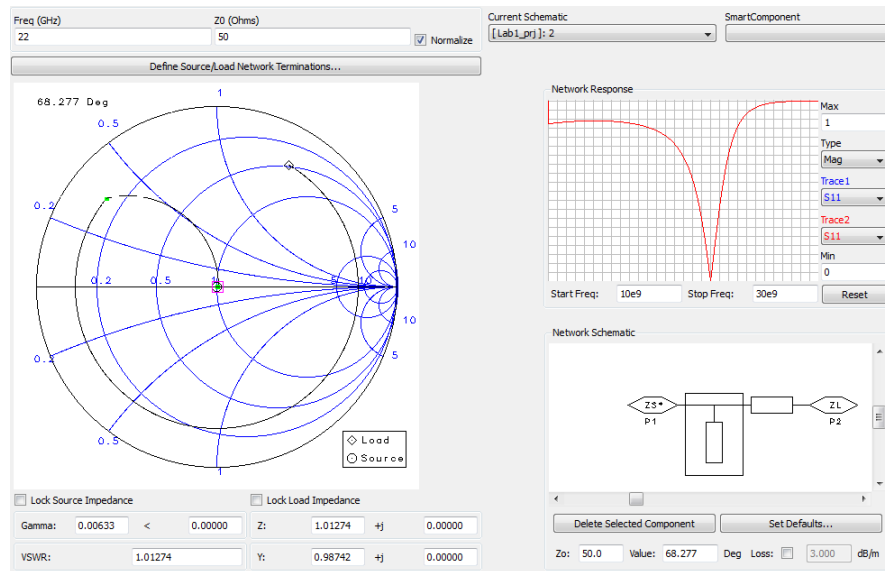


Figura 9: Determinação do comprimento eléctrico do *stub* de entrada - situação de CA.

Como se pode ver, para este caso o *stub* é maior e, como tal, não é a solução preferível.

Olhando agora para a malha de saída, ou seja, para a carga e sabendo que a malha de adaptação é do tipo linha-*stub*, o circuito que se pretende projectar é da seguinte forma.

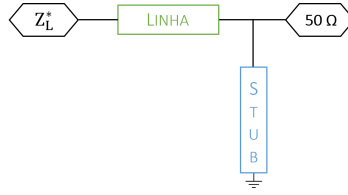


Figura 10: Malha de adaptação de saída.

Esta malha é construída com a adição de elementos, ou seja, *towards generator*. O valor de Z_L^* é de $0.628/39.020^\circ$.

No ADS, com recurso à Carta de Smith, determinou-se o comprimento eléctrico da linha, $\theta_{L_{out}}$, e o comprimento eléctrico do *stub*, $\theta_{S_{out}}$.

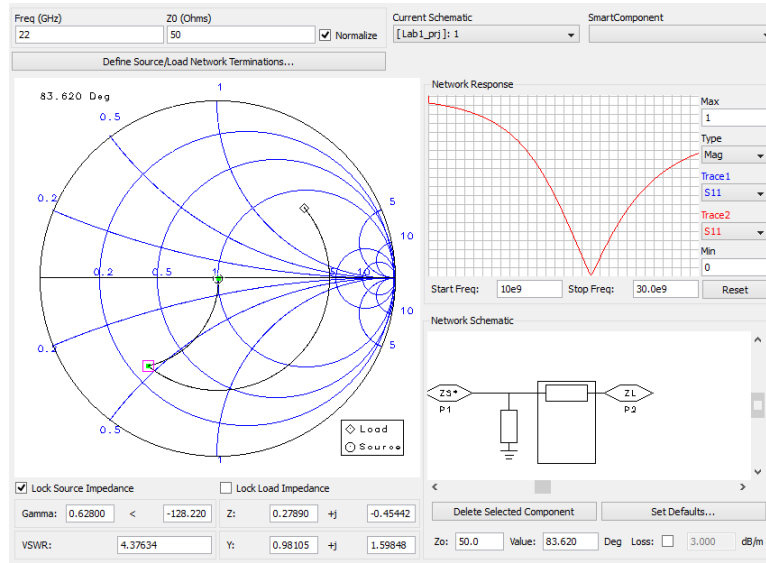


Figura 11: Determinação do comprimento eléctrico da linha de saída - situação de CC.

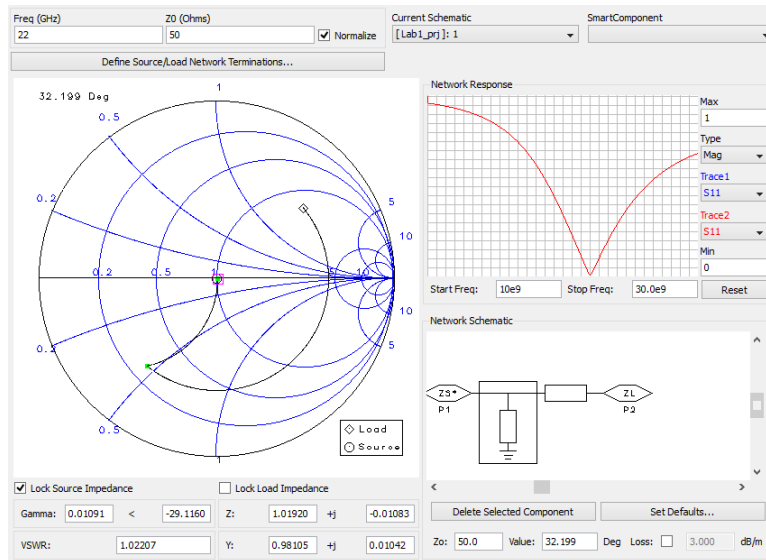


Figura 12: Determinação do comprimento eléctrico do *stub* de saída - situação de CC.

$$\theta_{L_{out}} = 83.620^\circ \text{ e } \theta_{S_{out}} = 32.199^\circ. \quad (2.4)$$

Simulação do Amplificador Ideal

Após obtermos os valores dos comprimentos eléctricos dos dispositivos que compõem as malhas de adaptação de entrada e saída através do ADS, poderemos então projectar um amplificador com malhas ideais compostas por dispositivos sem perdas. O circuito projectado pode ser observado na Figura 13.

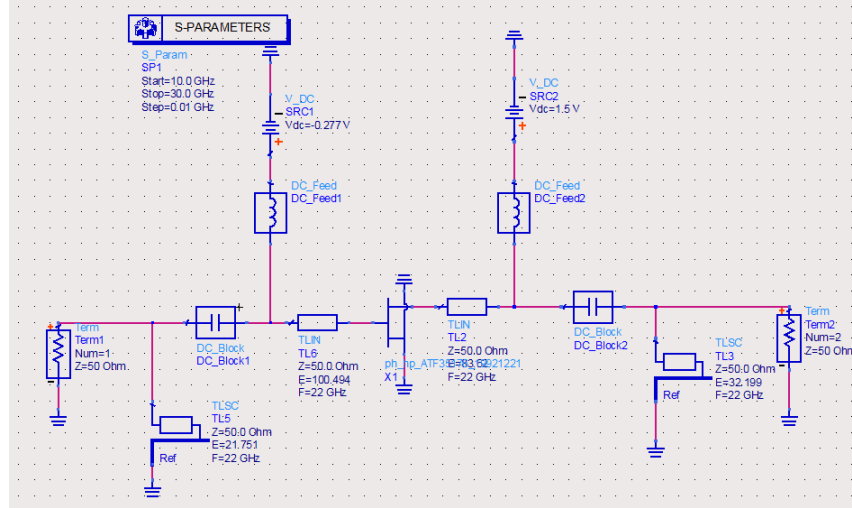


Figura 13: Circuito do Amplificador com linhas ideais.

Após o circuito estar montado, as linhas ideais com os seus comprimentos eléctricos e com frequência de referência centrada nos $22GHz$, foram realizadas várias simulações numa banda de frequências que compreende entre $10GHz$ a $30GHz$ de modo a obter os parâmetros pedidos, tal como se pode observar nas Figuras 14, 15 e 16.

Em primeiro lugar iremos testar a estabilidade do circuito, estabilidade esta que, teoricamente, já tinha sido garantida com a Equação 2.1 e com certos valores da Tabela 2. Tal como se pode ver na Figura 14, a variável de estabilidade apresenta sempre valores superiores a zero, o que confirma a estabilidade do amplificador na banda de $10GHz$ a $30GHz$.

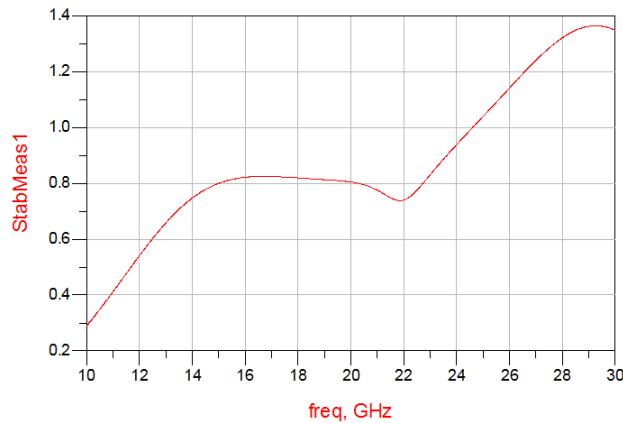


Figura 14: Estabilidade do Amplificador com linhas ideais.

Através da simulação foi possível obter os Parâmetros-S, sendo que a parcela $S(1,2)$ não representa

uma característica relevante no nosso amplificador, e por isso não foi projectada. Ao observar a Figura 15, e tendo em conta que a parcela $S(1,1)$ representa o factor de reflexão à entrada, $S(2,2)$ representa o factor de reflexão na saída e $S(2,1)$ representa o ganho de transdução.

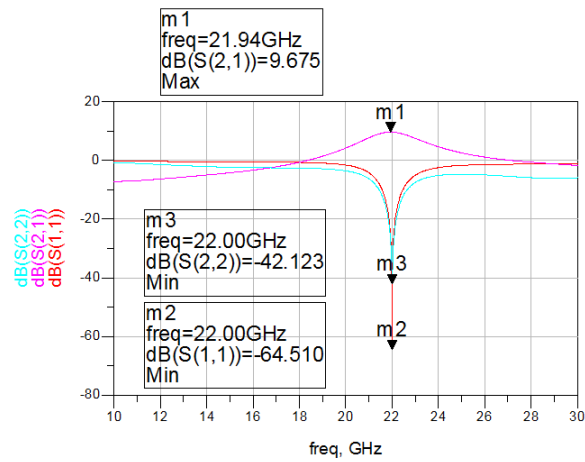


Figura 15: Parâmetros-S do Amplificador com linhas ideais.

Foi também possível medir o *noise* do amplificador ao longo da banda, e mais especificamente na frequência de referência sobre a qual o amplificador irá operar, tal como se pode observar na Figura 16.

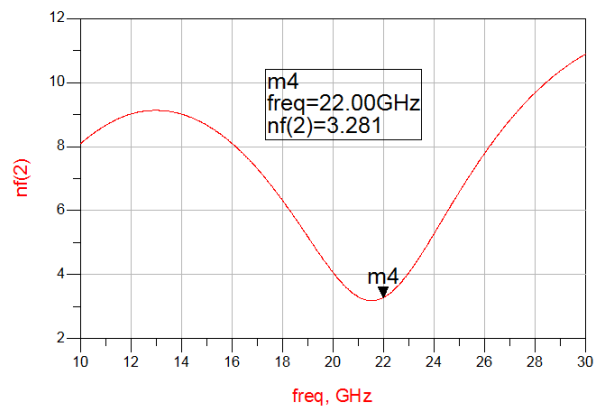


Figura 16: *Noise* no Amplificador com linhas ideais.

Tendo obtido os seguintes resultados da simulação:

- Ganho de transdução = $9.625dB$;
- Factor de reflexão à entrada = $-64.510dB$;
- Factor de reflexão na saída = $-42.123dB$;
- *noise* = 3.281 ;

Margarida
se quise-
res passa
estes va-
lores para
uma ta-
bela, deve
ser mais
bonito
Tirar con-
clusões
sobre isto,

2.1.2 b) Projecto do amplificador utilizando tecnologia microfita

Tendo já completado o projecto do amplificador com linha ideais, temos agora as características ideais que representam um objectivo que tentaremos alcançar, mas que no entanto o máximo que se pode aspirar é chegar o mais perto possível, pois no caso ideal não foram consideradas qualquer tipo de perdas.

Em primeiro lugar os blocos DC_Block e DC_Feed terão de ser substituídos por dispositivos reais com valores reais (condensadores e bobines respectivamente).

No caso do condensador, o seu valor tem de cumprir a condição especificada na Equação 2.5. No caso da bobine, o seu valor tem de cumprir a condição especificada na Equação 2.6.

$$\frac{1}{w_0 C_p} \gg 50 \Rightarrow C_p < \frac{1}{5.2\pi.22 * 10^9} \quad (2.5)$$

$$w_0 L_{CRK} \gg 50 \Rightarrow L_{CRK} > \frac{500}{2\pi.22 * 10^9} \quad (2.6)$$

Tendo escolhido valores que correspondam a condensadores/bobines que existam no mercado, os valores escolhidos podem ser consultados na Equação 2.7.

$$C_p = 1.3pF \text{ e } L_{CRK} = 3.9nH \quad (2.7)$$

Em segundo lugar teremos de substituir as linhas ideais por dispositivos reais, dispositivos estes que representam a tecnologia microfita utilizada no amplificador. Para tal objectivo será utilizado a ferramenta do ADS, **LineCalc**, como se pode ver na Figura 17, para calcular as dimensões das microfita a utilizar é necessário colocar as características do nosso substrato (Tabela 1), a frequência de referência e finalmente a impedância e comprimento eléctrico desejados para a microfita.

Figura 17: exemplo de **LineCalc**.

Numa primeira fase, as malhas de adaptação foram construídas com os elementos MLIN(linhas) e

MLSC(stubs), o circuito que se obteve está representado na Figura 18 e os seus parâmetros-S podem ser observados na Figura 19.

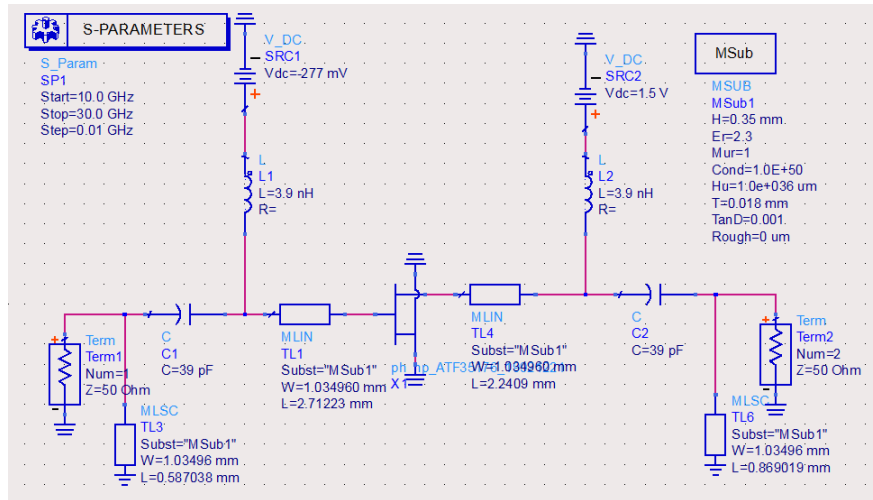


Figura 18: Circuito com microfitas, linhas e stubs.

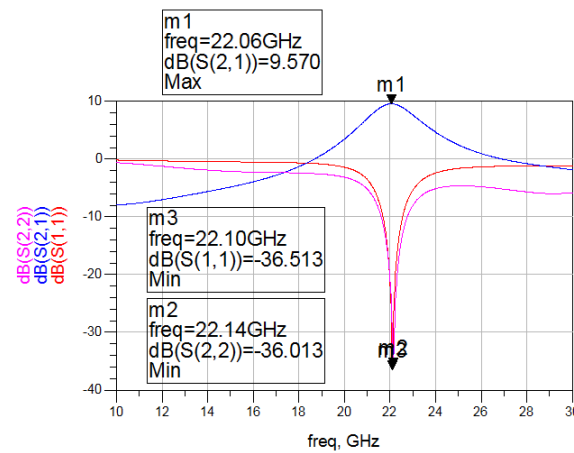


Figura 19: Parâmetros-S do amplificador com malhas de linhas e stubs.

Os resultados desta simulação são bastante satisfatórios, no entanto, como foi explicado anteriormente, não será possível utilizar este circuito. Ao observarmos as dimensões dos dispositivos MLSC, reparamos que a sua largura é superior ao seu comprimento, tendo então de representar estes elementos com outros dispositivos, MLOC. Ao dimensionar MLOC, no entanto, o comprimento eléctrico considerado tem de ser incrementado com 90 graus, um exemplo da progressão do processo da dimensão do stub da malha de adaptação pode ser observado na Figura 20.

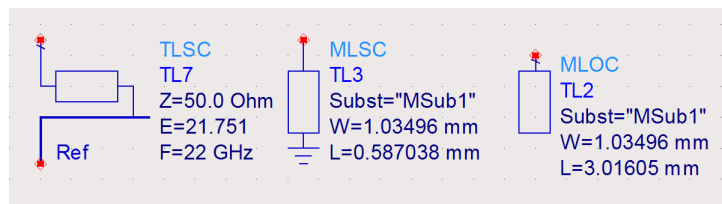


Figura 20: Linha ideal - stub - loc

Com esta modificação obtemos um circuito diferente do anterior(Figura 21) onde testaremos os seus parâmetros tal como fizemos para o circuito com linhas ideais(Figura 13). Estas simulações estão representadas nas Figuras 22, 23 e 24

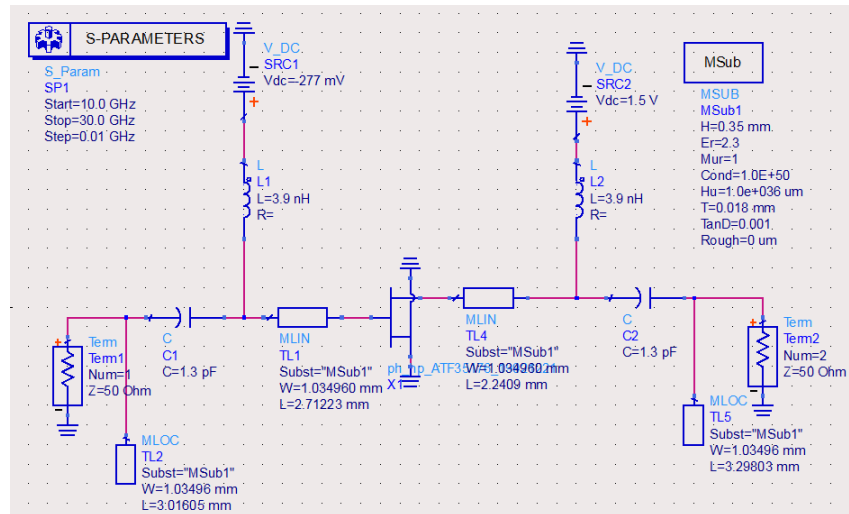


Figura 21: Circuito com microfitas, linhas e locs.

Como se pode observar na Figura 22, mais uma vez a variável mantém-se superior a zero, podendo afirmar que o amplificador é estável.

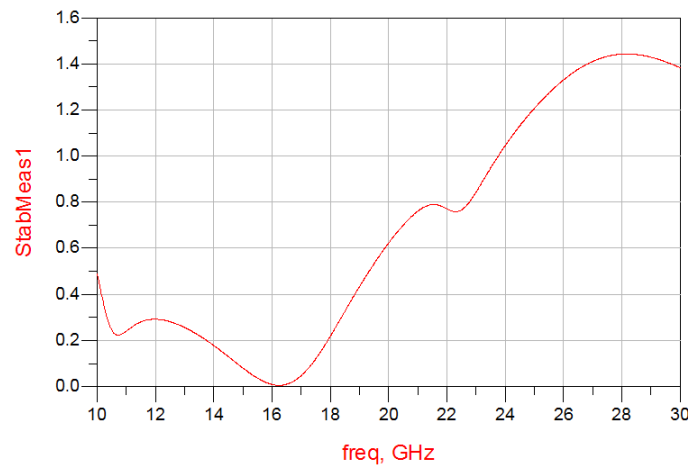


Figura 22: Estabilidade do Amplificador com malhas de linhas e locs.

Na Figura 23 podemos observar que os gráficos apresentam uma forma muito diferente da apresentada antes da alteração nos stubs (Figura 19), esta mudança também é verificada na Figura 24, ambos os gráficos não apresentaram a forma esperada da simulação do amplificador de linhas ideais, efeito este causado pela alteração realizada nos stubs.

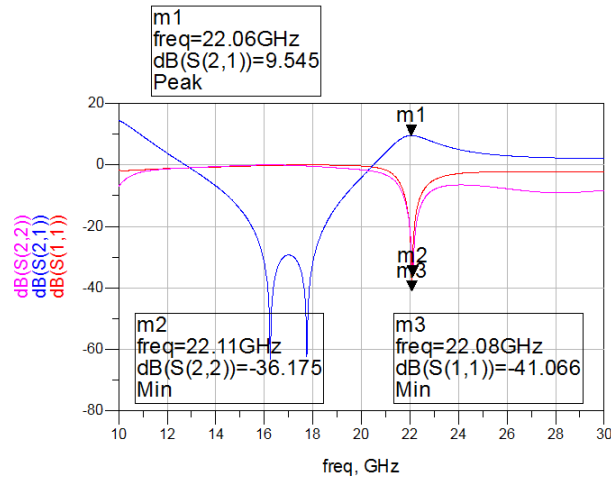


Figura 23: Parâmetros-S do Amplificador com malhas de linhas e locs.

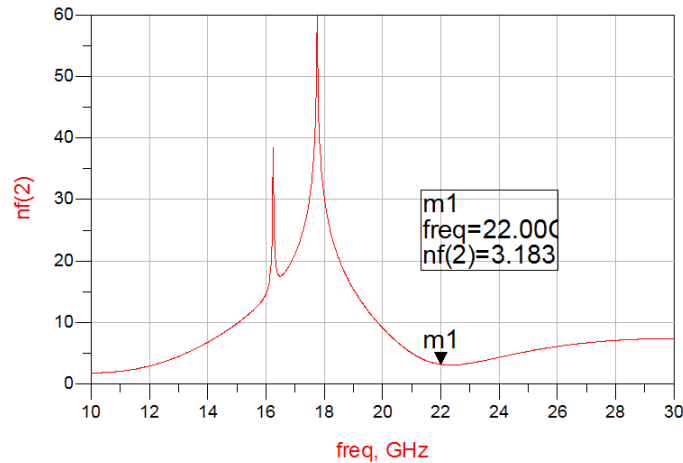


Figura 24: Noise do Amplificador com malhas de linhas e locs.

A diferença entre os gráficos obtidos no amplificador de linhas ideais (Figuras 14, 15 e 16) e o amplificador com a tecnologia de microfita (Figuras 22, 23 e 24) são ainda relevantes, especialmente em zonas perto das frequências $16GHz$ e $18GHz$, no entanto, os valores que se obtêm para a frequência de $22GHz$ não apresentam diferenças tão relevantes, tal como se pode observar na Tabela

2.2 Concretização do amplificador em tecnologia de microfita

Nesta segunda fase o circuito do amplificador será todo projectado com a tecnologia de microfita e irá ser projectado um layout do circuito.

2.2.1 a) Introdução de elementos que simulam descontinuidades nas linhas

Em primeiro lugar teremos de substituir ambas as bobines por dispositivos que utilizem a tecnologia de microfita, ambas as bobines com as suas fontes de tensão terão de ser substituídas pelo bloco demonstrado na Figura 25.

Tabela com os resultados, talvez continuemos os resultados das linhas ideais para ser mais fácil comparar

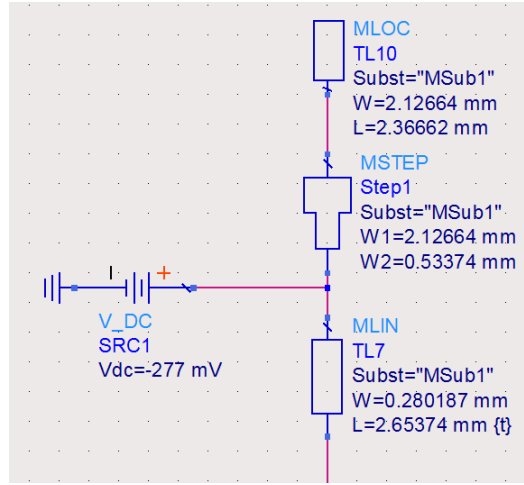


Figura 25: Bloco que substitui bobines e fontes de tensão.

O elemento MLIN com o nome de TL7 representado na Figura 25 tem dimensões obtidas através da ferramenta LineCalc já antes utilizada, no entanto, como argumentos, recebe impedância característica de 100Ω e comprimento eléctrico de 90° . O elemento MLIN com o nome de TL8 tem dimensões calculadas através do mesmo método no entanto recebe como impedância característica um valor de 30Ω . Esta alteração no cálculo das dimensões de ambos os elementos MLIN irá causar uma diferença na largura de ambos, sendo necessário usar um elemento MSTEP que tem como objectivo servir de "adaptador" para a diferença das larguras entre os canais.

Em relação às quatro descontinuidades criadas nos nós dos circuitos serão usados elementos MTEE que terão como função criar uma junção entre três canais e também, se necessário, adaptar as suas larguras. O resultado destas modificações no circuito do amplificador podem ser observadas na Figura 26.

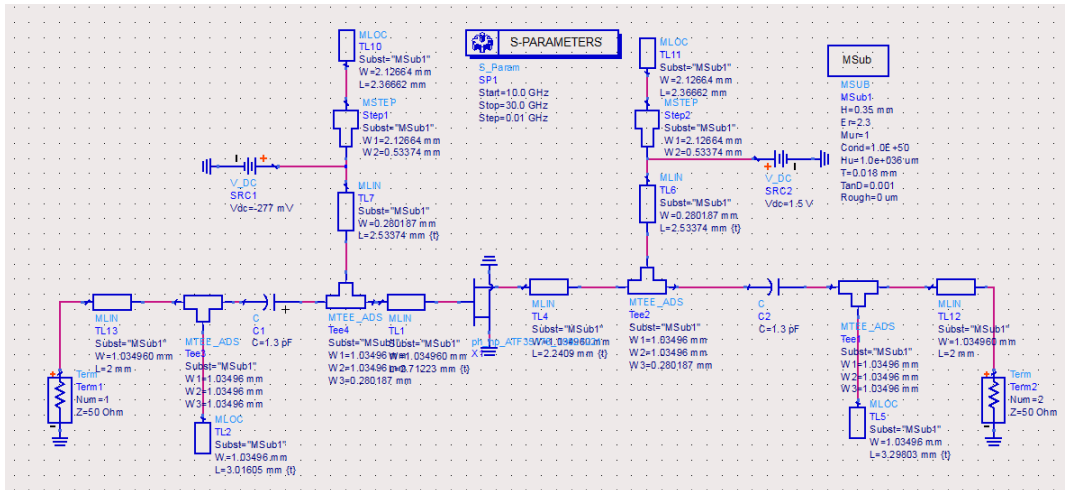


Figura 26: Amplificador com as descontinuidades simuladas.

Após ter o circuito projectado é possível observar os parâmetros-S que caracterizam o amplificador na Figura 27

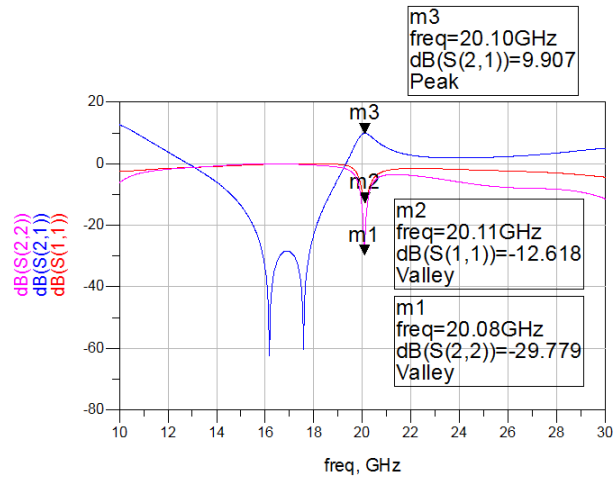


Figura 27: Simulação dos Parâmetros-S do amplificador com descontinuidades simuladas pré_TUNE.

Como se pode observar, os resultados obtidos não são satisfatórios, os valores máximos/mínimos não se encontram centrados na frequência desejada e não apresentam valores tão próximos do esperado, foi então usada a ferramenta TUNE nos comprimentos dos elementos MLIN com o nome de TL2, TL1, TL4, TL5, TL7, TL10, TL6 e TL11 representados na Figura 26, onde foi possível obter as características representadas na Figura 28.

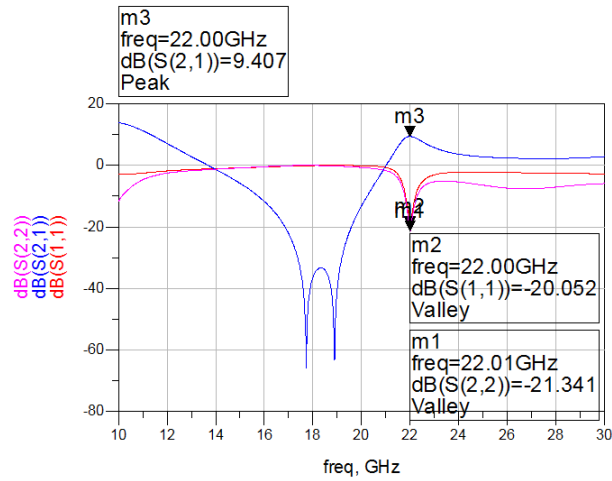


Figura 28: Simulação dos Parâmetros-S do amplificador com descontinuidades simuladas pré_TUNE.

Podemos observar também o gráfico de estabilidade (Figura 29) e o gráfico do *noise* (Figura 30).

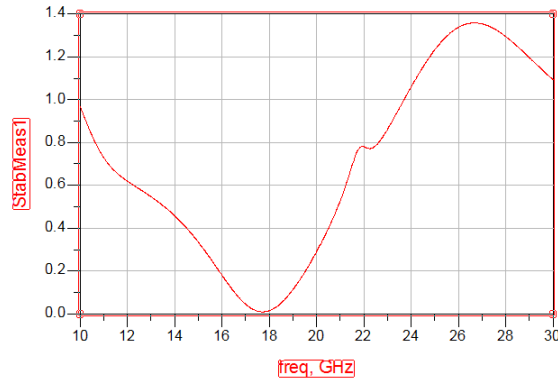


Figura 29: Estabilidade do amplificador com descontinuidades simuladas pré_TUNE.

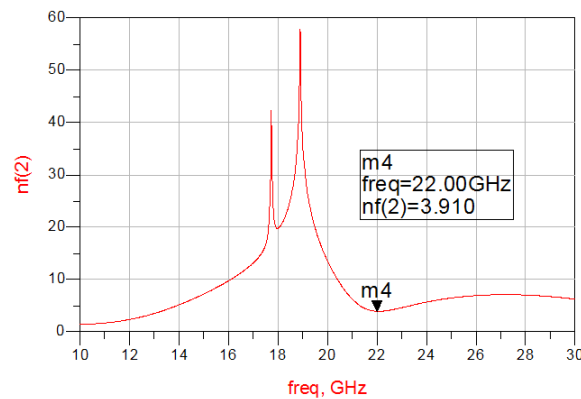


Figura 30: Estabilidade do amplificador com descontinuidades simuladas pré_TUNE.

2.2.2 b) Substituição do transístor e condensadores

Em primeiro lugar temos de descobrir as dimensões dos condensadores, sabendo que estes têm um valor de $1.3pF$, foi necessário recorrer a uma *datasheet* de condensadores com esse valor, as suas dimensões podem ser consultadas na Figura 31 (de notar que esses valores se encontram em *inches*), e são calculadas na Equação 2.8.

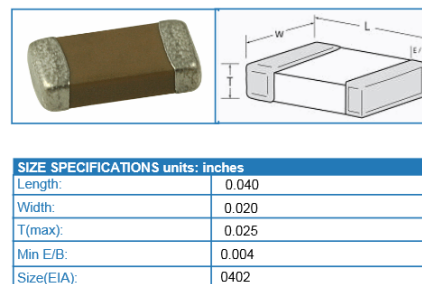


Figura 31: Dimensões dos condensadores.

Fazer uma
tabela
com os
parametros
S e noise
com os
valores
da linha
ideal,
microfita,
des-
cont_pre_tu
e des-
cont_pre_tu
Depois
comenta-
se

$$W = 0.508mm \text{ e } S = L - 2 * \frac{E}{B} = 0.8128mm \quad (2.8)$$

Podemos então descobrir a dimensão dos elementos **MGAP** a utilizar para substituir os condensadores, no entanto, como os condensadores têm uma largura diferente da do canal onde está a ser inserido, teremos de usar **MSTEP**'s para adaptar os nossos condensadores ao canal.

Para substituir o transistor pelo elemento **MGAP** teremos de descobrir as dimensões de largura e comprimento a utilizar, ao se consultar o *datasheet* do transistor é possível concluir que o encapsulamento tem $1.76mm$, pelo que é necessário uma dimensão **S** do elemento **MGAP** ligeiramente superior, digamos $2.5mm$. Em relação à largura do **MGAP**, esta tem de coincidir com o tamanho das patas da *gate* e do *dreno* do transistor, $0.51mm$. Mais uma vez, como a dimensão da largura do **MGAP** não é igual à do canal em que este será inserido, foram usados elementos **MSTEP** para adaptar o canal.

O Circuito que resulta destas substituições dos condensadores e transistores pode ser observado na Figura 32.

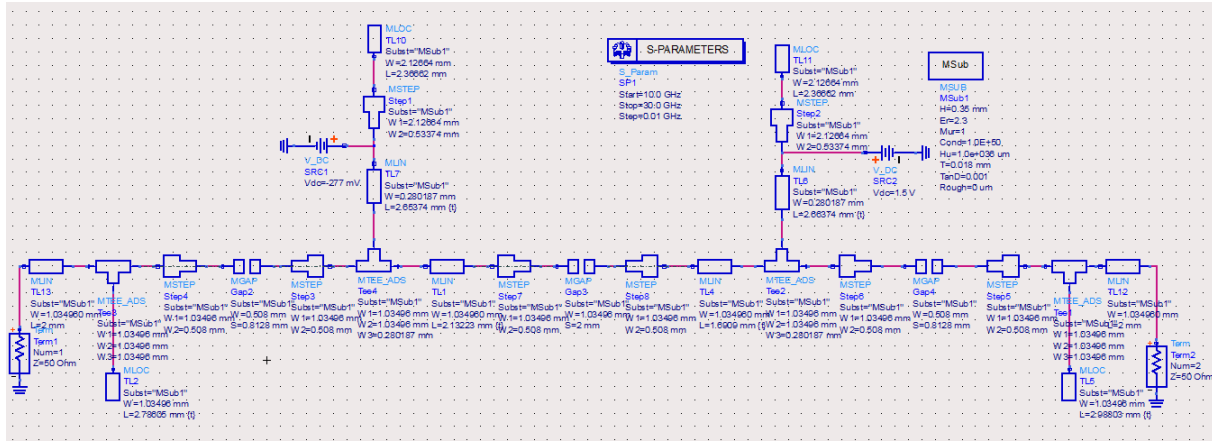


Figura 32: Circuito que corresponde ao projecto de layout do amplificador.

Ao ter o circuito totalmente projectado, é possível usar a ferramenta **layout** do ADS para construir o layout do circuito, que pode ser observado na Figura 33.

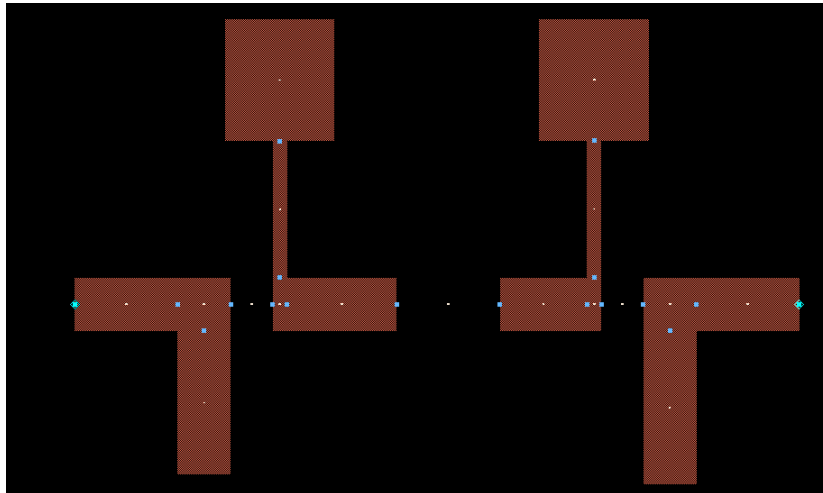


Figura 33: Circuito que corresponde ao projecto de layout do amplificador.

3 Conclusões